

令和7年7月1日

三次元半導体研究センター
ご利用の皆様

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団

理事長 津田 純嗣

(三次元半導体研究センター)

新型装置の導入等に伴う機器利用料金改定について（お知らせ）

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

このたび、新型装置の導入及び一部機器の利用実態を踏まえ、料金の改定等をいたしました。

今後も研究開発支援を通じて、より一層皆様のお役に立てるよう努力してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1 新規導入機器の料金改定について（令和7（2025）年7月1日より適用）

機器名	設置場所	新料金(税抜・1時間)
超音波探傷装置 【(株)SRT:VSA M350】	実装エリア	8,800
※有機溶剤現像装置 【ミカサ(株)、(株)ダルトン:AD-3000】	クリーンルーム G	9,000

※ 現在、溶剤(Cyclopentanone、PGMEA)の安定供給が難しいため、溶剤は持ち込みをお願いしています。

ご利用希望の場合はあらかじめ担当研究員へご相談お願いいたします。

2 その他機器の利用料金について（令和7（2025）年7月1日より適用）

詳細は別添「機器利用料金単価表（新旧対照表）」をご確認ください。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団

三次元半導体センター 管理グループ

担当：蓮實・山下・小野本

TEL:092-331-8510 / E-Mail: jiss-itoshima@ist.or.jp

改正案				現行			
(別紙 1)				(別紙 1)			
三次元半導体研究センター 機器利用料金単価表				三次元半導体研究センター 機器利用料金単価表			
(令和 7 年 7 月 1 日改訂)				(令和 7 年 4 月 1 日改訂)			
No.	機器名	設置場所	料金 (税抜)	No.	機器名	設置場所	料金 (税抜)
7	乾燥炉200℃	クリーンルーム B	3,000	7	乾燥炉200℃	クリーンルーム B	3,000
9	予熱ラミネーター	クリーンルーム B	3,200	9	予熱ラミネーター	クリーンルーム B	3,200
11	クリーンローラ	クリーンルーム B	2,400	11	クリーンローラ	クリーンルーム B	2,400
12	真空ラミネータ	クリーンルーム B	7,800	12	真空ラミネータ	クリーンルーム B	7,800
21	プリント基板用直接描画装置	クリーンルーム B	29,800	21	プリント基板用直接描画装置	クリーンルーム B	29,800
23	乾燥炉360℃	クリーンルーム B	3,000	23	乾燥炉360℃	クリーンルーム B	3,000
23-2	乾燥炉	クリーンルーム E	3,000	23-2	乾燥炉	クリーンルーム E	3,000
23-3	乾燥炉Si専用	クリーンルーム D	3,000	23-3	乾燥炉Si専用	クリーンルーム D	3,000
30	プリント基板用プラズマクリーナー	クリーンルーム B	6,900	30	プリント基板用プラズマクリーナー	クリーンルーム B	6,900
66	マイクロフォーカスX線透視装置	クリーンルーム C	4,100	66	マイクロフォーカスX線透視装置	クリーンルーム C	4,100
43	ガラス(支持)基板貼合せ装置	クリーンルーム D	5,700	43	ガラス(支持)基板貼合せ装置	クリーンルーム D	5,700
44	ガラス(支持)基板剥離装置	クリーンルーム D	8,400	44	ガラス(支持)基板剥離装置	クリーンルーム D	8,400
45	照射器移動方式紫外線照射装置	クリーンルーム D	3,000	45	照射器移動方式紫外線照射装置	クリーンルーム D	3,000
46	オートマチックサーフェスグラインダー	クリーンルーム D	11,500	46	オートマチックサーフェスグラインダー	クリーンルーム D	11,500
48	オートマチックダイシングソー	クリーンルーム D	7,800	48	オートマチックダイシングソー	クリーンルーム D	7,800
49	ストレスリリーフ研磨装置	クリーンルーム D	10,300	49	ストレスリリーフ研磨装置	クリーンルーム D	10,300
R1	高温クリーンオープン	クリーンルーム D	8,500	R1	高温クリーンオープン	クリーンルーム D	8,500
47	8 インチ用ウェハマニュアル洗浄装置	クリーンルーム E	3,600	47	8 インチ用ウェハマニュアル洗浄装置	クリーンルーム E	3,600
53	ウェハーカップ式銅メッキ装置	クリーンルーム E	14,300	53	ウェハーカップ式銅メッキ装置	クリーンルーム E	14,300
55	半導体用クリーンルーム対応リフロー炉	クリーンルーム E	8,300	55	半導体用クリーンルーム対応リフロー炉	クリーンルーム E	8,300
50	リアクティブイオンエッチャー	クリーンルーム F	15,700	50	リアクティブイオンエッチャー	クリーンルーム F	15,700
51	絶縁膜形成装置	クリーンルーム F	14,700	51	絶縁膜形成装置	クリーンルーム F	14,700
52	縦型酸化炉	クリーンルーム F	8,200	52	縦型酸化炉	クリーンルーム F	8,200
65	電界放出型分析走査電子顕微鏡	クリーンルーム F	13,300	65	電界放出型分析走査電子顕微鏡	クリーンルーム F	13,300
40	微細パターン加工装置	クリーンルーム G	17,300	40	微細パターン加工装置	クリーンルーム G	17,300
41	スピニングコーター	クリーンルーム G	4,900	41	スピニングコーター	クリーンルーム G	4,900
42	アルカリデベロッパ	クリーンルーム G	5,400	42	アルカリデベロッパ	クリーンルーム G	5,400
16	プリント基板用高速スクリーン印刷機	実装エリア	5,300	16	プリント基板用高速スクリーン印刷機	実装エリア	5,300
17	プロダクションモジュラー	実装エリア	6,000	17	プロダクションモジュラー	実装エリア	6,000
19	大型基板対応フリップチップボンダ	実装エリア	12,200	19	大型基板対応フリップチップボンダ	実装エリア	12,200

三次元半導体研究センター 機器利用料金単価表 新旧対照表

改正案				現行					
	24	鉛フリー対応N2リフロー装置	実装エリア	5,800		24	鉛フリー対応N2リフロー装置	実装エリア	5,800
	32	内蔵部品検査装置	実装エリア	8,700		32	内蔵部品検査装置	実装エリア	8,700
	R5	熱衝撃試験機	実装エリア	1,300		R5	熱衝撃試験機	実装エリア	1,300
	13	乾燥炉200℃	水平ライン室	3,000		13	乾燥炉200℃	水平ライン室	3,000
	27	基板用現像装置	水平ライン室	11,200		27	基板用現像装置	水平ライン室	11,200
	28	ソフトエッチ水洗装置	水平ライン室	9,700		28	ソフトエッチ水洗装置	水平ライン室	9,700
	29	レジスト剥離装置	水平ライン室	14,500		29	レジスト剥離装置	水平ライン室	14,500
	31	基板用ケミカルエッチング装置	水平ライン室	12,900		31	基板用ケミカルエッチング装置	水平ライン室	12,900
	25	基板用バフ研磨装置	めっきライン室	7,500		25	基板用バフ研磨装置	めっきライン室	7,500
	34	積層前粗化処理装置	めっきライン室	11,700		34	積層前粗化処理装置	めっきライン室	11,700
	35	デスミア装置	めっきライン室	14,200		35	デスミア装置	めっきライン室	14,200
	36	基板用無電解めっき装置	めっきライン室	12,200		36	基板用無電解めっき装置	めっきライン室	12,200
	37	電解ビアフィルめっき装置	めっきライン室	15,500		37	電解ビアフィルめっき装置	めっきライン室	12,600
	3	プリント基板用X線ガイド穴明機	機械加工室	5,900		3	プリント基板用X線ガイド穴明機	機械加工室	5,900
	4	プリント基板穴明機	機械加工室	6,500		4	プリント基板穴明機	機械加工室	6,500
	5	プリント基板外形加工機	機械加工室	5,400		5	プリント基板外形加工機	機械加工室	5,400
	8	ピン立て装置	機械加工室	3,200		8	ピン立て装置	機械加工室	3,200
	20	プリント配線板用UV+CO ₂ レーザ加工機	機械加工室	15,800		20	プリント配線板用UV+CO ₂ レーザ加工機	機械加工室	15,800
	60	恒温恒湿振動試験機	信頼性試験室	8,100		60	恒温恒湿振動試験機	信頼性試験室	8,100
	61	衝撃試験装置	信頼性試験室	8,300		61	衝撃試験装置	信頼性試験室	8,300
	62	自動切断機	信頼性試験室	900		62	自動切断機	信頼性試験室	900
	63	自動研磨機(64 研磨濾過器含む)	信頼性試験室	4,100		63	自動研磨機(64 研磨濾過器含む)	信頼性試験室	4,100
	57	ブローピングシステム	電気特性評価室	3,400		57	ブローピングシステム	電気特性評価室	3,400
	R3	ブローピングシステム (120GHz)	電気特性評価室	4,200		R3	ブローピングシステム (120GHz)	電気特性評価室	4,200
	58	高周波パラメータ測定システム	電気特性評価室	11,900		58	高周波パラメータ測定システム	電気特性評価室	11,900
	59	TDRオシロスコープ	電気特性評価室	5,500		59	TDRオシロスコープ	電気特性評価室	5,500
	74	基板パラメータ測定システム	電気特性評価室	2,900		74	基板パラメータ測定システム	電気特性評価室	2,900
	R2	120GHzネットワークアナライザ	電気特性評価室	33,630		R2	120GHzネットワークアナライザ	電気特性評価室	33,630
	R4	ダブルパルステスター	電気特性評価室	5,500		R4	ダブルパルステスター	電気特性評価室	5,500
	2	プリント基板真空プレス装置	プレス室	10,700		2	プリント基板真空プレス装置	プレス室	10,700
	L1	レーザー顕微鏡	検査室	4,700		L1	レーザー顕微鏡	検査室	4,700
	L2	フリップチップボンダー	クリーンルームC	11,600		L2	フリップチップボンダー	クリーンルームC	11,600
	L3	ワイヤーボンダー	クリーンルームC	5,700		L3	ワイヤーボンダー	クリーンルームC	5,700
	L4	ボンドテスタ	クリーンルームC	4,000		L4	ボンドテスタ	クリーンルームC	4,000

三次元半導体研究センター 機器利用料金単価表 新旧対照表

改正案				現行			
L5	F I B	クリーンルーム C	13,400	L5	F I B	クリーンルーム C	13,400
L7	ウェハープラズマクリーナー	クリーンルーム G	5,300	L7	ウェハープラズマクリーナー	クリーンルーム G	5,300
L8	酸化膜エッチング装置	クリーンルーム F	9,100	(追加)	(追加)	(追加)	(追加)
80	反応性イオンエッチング装置	クリーンルーム F	10,500	80	反応性イオンエッチング装置	クリーンルーム F	10,500
81	超音波探傷装置	実装エリア	8,800	(追加)	(追加)	(追加)	(追加)
82	有機溶剤現像装置	クリーンルーム G	9,000	(追加)	(追加)	(追加)	(追加)
L9	ピール試験機	検査室	3,300	L9	ピール試験機	検査室	3,300
L10	マイグレーション評価装置	信頼性試験室	2,500	L10	マイグレーション評価装置	信頼性試験室	2,500
s1	ウェハ銅ポストめっき	クリーンルーム E	4,300	s1	ウェハ銅ポストめっき	クリーンルーム E	4,300
s2	SnAgめっき	クリーンルーム E	4,300	s2	SnAgめっき	クリーンルーム E	4,300
s3	電解Niめっき	クリーンルーム E	25,000	s3	電解Niめっき	クリーンルーム E	25,000
s4	Ni/Auめっき	クリーンルーム E	50,800	s4	Ni/Auめっき	クリーンルーム E	50,800
81	ドライフィルム剥離	クリーンルーム F	3,000	81	ドライフィルム剥離	クリーンルーム F	3,000
s5	チタン/Cu スパッタ	クリーンルーム F	40,600	s5	チタン/Cu スパッタ	クリーンルーム F	40,600
s6	二流体洗浄装置	クリーンルーム E	5,800	s6	二流体洗浄装置	クリーンルーム E	5,800
s7	基板用Ni/Auめっき	水平ライン室	102,000	s7	基板用Ni/Auめっき	水平ライン室	102,000
E43	デジタルマイクロスコープ	クリーンルーム C	1,700	E43	デジタルマイクロスコープ	クリーンルーム C	1,700